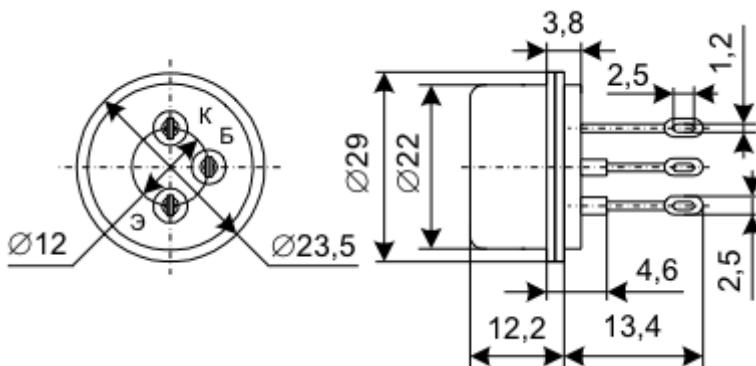




2T809A

Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры п-р-п переключательные.
Предназначены для применения в переключающих и импульсных устройствах.
Корпус металлический со стеклянными изоляторами и жесткими выводами.
Масса транзистора без накладного фланца не более 22 г, с фланцем - не более 34 г.
Тип корпуса: КТЮ-3-20. Технические условия: аА0.365.003 ТУ.



Основные технические характеристики транзистора 2T809A:

- $h_{21\alpha}$ - Статический коэффициент передачи тока для схем с ОЭ при $U_{\text{кэ}}=5$ В, $I_{\text{k}}=2$ А, $t_{\text{k}} = +25^{\circ}\text{C}$: 15...100;
- $U_{\text{кэ нас}}$ – Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_{\text{k}}=2$ А, $I_{\text{б}}=0,4$ А: не более 1,5 В;
- $U_{\text{бэ нас}}$ – Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_{\text{k}}=2$ А, $I_{\text{б}}=0,4$ А: не более 2,3 В;
- $t_{\text{рас}}$ - Время рассасывания при $U_{\text{кэ}}=15$ В, $I_{\text{k}}=6$ А: не более 3 мкс;
- $I_{\text{кэо}}$ - Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{\text{кэ}}=400$ В, $R_{\text{бэ}}=10$ Ом, $t_{\text{k}} \leq +25^{\circ}\text{C}$: не более 3 мА;
- $I_{\text{эбо}}$ - Обратный ток эмиттера при $U_{\text{бэ}}=4$ В: не более 50 мА;
- $C_{\text{к}}$ - Емкость коллекторного перехода: не более 270 пФ;
- $U_{\text{кэ max}}$ - Максимальное постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{\text{бэ}}=10$ Ом, $t_{\text{п}} \leq 100^{\circ}\text{C}$: 400 В;
- $U_{\text{эбо max}}$ - Максимальное напряжение база-эмиттер: 4 В;
- $I_{\text{k max}}$ - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 3 А;
- $I_{\text{k и max}}$ - Максимально допустимый импульсный ток коллектора при $t_{\text{i}} \leq 400$ мкс, $Q \geq 10$: 15 А;
- $P_{\text{к т max}}$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $t_{\text{k}} \leq +50^{\circ}\text{C}$: не более 40 Вт;
- $t_{\text{п}}$ – Температура р-п перехода: не более $+150^{\circ}\text{C}$;
- $t_{\text{окр}}$ – Температура окружающей среды: $-60 \dots t_{\text{k}}=+125^{\circ}\text{C}$.